www.DataSheet4U.com

UNITRA CEMI

UL 1321N

Układ podwójnego przedwzmacniacza akustycznego

Obudowa CE 70

Układ UL 1321 zawiera:
- dwa przedwzmacniacze m.cz.,
- oddzielny tranzystor.

Charakteryzuje się następującymi cechami:
- ma duże wzmocnienie z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego /60 dB/,
- ma możliwość regulacji wzmocnienia przez zewnętrzną pętlę sprzężenia zwrotnego.

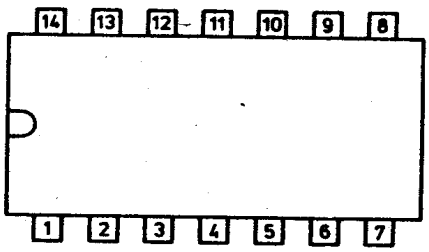
Układ przeznaczony jest do zastosowań we wzmacniaczach stereofonicznych.

Parametry dopuszczalne

/t_{amb} = +25°C/

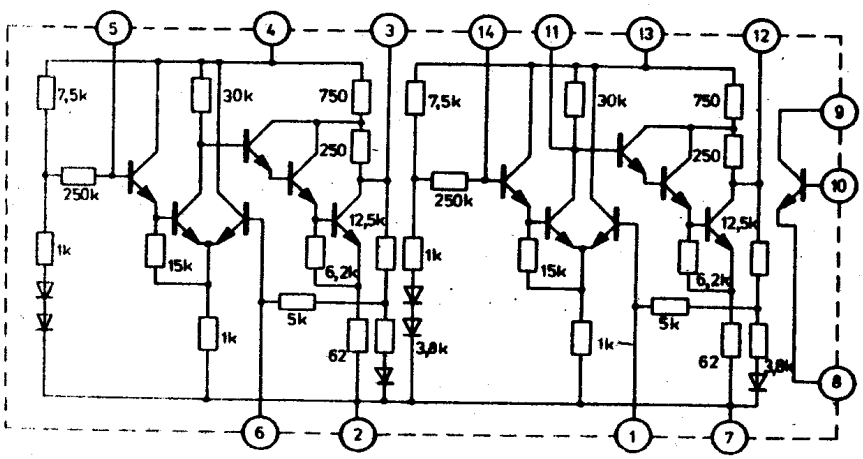
Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość	
			min	max
U_{CC}	Napięcie zasilania	V		18
t_{amb}	Temperatura otoczenia w czasie pracy	°C	-25	+70
t_{stg}	Temperatura przechowywania	°C	-40	+125

Układ wyprowadzeń



Opis wyprowadzeń

1. Sprzężenie zwrotne przedwzm. II
2. Masa układu
3. Wyjście przedwzmacniacza I
4. Zasilanie przedwzm. I
5. Wejście przedwzm. I
6. Sprzężenie zwrotne przedwzm. I
7. Masa układu
8. Emiter tranzystora dodatkowego
9. Kolektor tranzystora dodatkowego
10. Baza tranzystora dodatkowego
11. Tłumienie oscylacji
12. Wyjście przedwzm. II
13. Zasilanie przedwzm. II
14. Wejście przedwzm. II



Schemat wewnętrzny

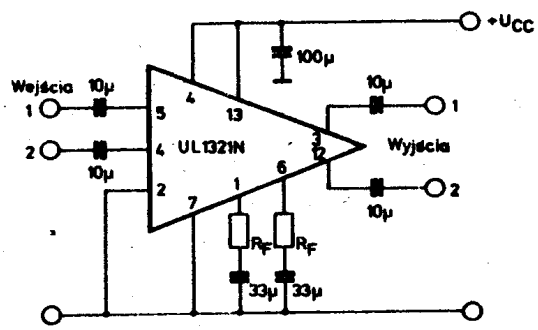
www.DataSheet4U.com

www.DataSheet4U.com

Parametry charakterystyczne

$/t_{amb} = +25^{o}C/$

Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość			Warunki pomiaru Uwagi
			min	typ	max	
I_{CCQ}	Spoczynkowy prąd zasilania I_4, I_{13}	mA		3,5	6,0	U_{CC}=6 V; f_p=1 kHz
$A_{U\infty}$	Wzmocnienie napięciowe /przy rozwartej pętli sprzężenia zwrotnego/	dB		60		U_{CC}=6 V; f_p=1 kHz U_I=0,5 mV
A_U	Wzmocnienie napięciowe	dB	45			U_{CC}=6 V; f_p=1 kHz U_I=1 mV; R_f=100Ω
U_O	Napięcie wyjściowe	V	1			U_{CC}=6 V; f_p=1 kHz h=5%; R_f=100Ω
BW	Szerokość pasma przenoszenia	kHz	400			U_{CC}=6 V; f_p=1 kHz; U_I=0,5 V
h	Współczynnik zawartości harmonicznych	%			0,9	U_{CC}=6 V; f_p=1 kHz; U_O=0,5 V; R_f=100Ω
R_I	Rezystancja wejściowa	kΩ		90		U_{CC}=6 V; f_p=1 kHz
R_O	Rezystancja wyjściowa	kΩ		1		U_{CC}=6 V; f_p=1 kHz
U_{IN}	Napięcie szumów	μV			3	U_{CC}=10 V; R_g=600Ω
S	Tłumienie przesłuchu	dB		40		
h_{21E}	Statyczny współczynnik wzmocnienia prądowego dodatkowego tranzystora		70	150		U_{CE}=3 V; I_C=1 mA
$U_{/BR/CEO}$	Napięcie przebicia kolektor-emiter dodatkowego tranzystora	V	15			I_C=1 mA
$U_{/BR/CBO}$	Napięcie przebicia kolektor-baza dodatkowego tranzystora	V	25			I_C=1 μA
I_{EBO}	Prąd zerowy emitera	μA			1	I_C=0 A; U_{EB}=4 V



Schemat aplikacyjny

www.DataSheet4U.com